

ชื่อโครงการ การศึกษากายภาพเชิงแสงของวัสดุฐานเพอรอฟสไกต์สำหรับโฟโตวอลเทอิกประยุกต์ Photophysical Study of Perovskite-Based Material for Photovoltaic Application

ชื่อนิสิต	นายจักรภัทร แย้มทิม
	นายณัฐปคัลภ์ รอดดอนไพร

เลขประจำตัว 5932907823เลขประจำตัว 5932921523

- **ภาควิชา** เคมีเทคนิค
- **ปีการศึกษา** 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการการ	ศึกษากายภาพเชิงแสงของวัสดุฐานเพอรอฟสไกต์สำหรับโฟโตวอลเทอิกประยุกต์
ชื่อนิสิตผู้ทำโครงการ	นาย จักรภัทร แย้มทิม
	นาย ณัฐปคัลภ์ รอดดอนไพร
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร. ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ

ภาควิชา เคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

เซลล์สุริยะชนิดเพอรอฟสไกต์ (Perovskite solar cells; PCE) ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนรูปพลังงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา PCE จัดอยู่ในกลุ่มเซลล์สุริยะรุ่นใหม่ที่มี ศักยภาพสูง อย่างไรก็ตามกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแส-แรงดัน (current densityvoltage curve) ของ PCE ปรากฏพฤติกรรมฮิสเทอรีซิส (Hysteresis behavior) ซึ่งเป็นอุปสรรคหลัก สำหรับการใช้งาน PCE ในเชิงพาณิชย์ จากงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้าพบว่าไทรแคตไอออน (trication, X³⁺) สามารถลดฮิสเทอรีซิสและเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานของ PCE ได้ โครงงานนี้นำเสนอผลของ การเจือโบรอนในชั้นนำอิเล็กตรอน (Electron transport layer; ETL) ของPCE โดยสร้างแบบจำลองทฤษฎี ฟังก์ชันนัลความหนาแน่น (Density functional theory; DFT) ของชั้นนำอิเล็กตรอนไททาเนียมไดออกไซด์ เพื่อใช้อธิบายภาวะการพร่องออกซิเจนในโครงสร้าง (oxygen vacancies) นำไปสู่องค์ความรู้พื้นฐานเรื่อง ปัจจัยของการเกิดภาวะการพร่องและวิธีลดการพร่องในชั้นนำอิเล็กตรอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ ชนิดเมทิลแอมโมเนียมเลดไอโอไดด์เพอรอฟสไกต์ต่อไป

คำสำคัญ : เซลล์สุริยะชนิดเพอรอฟสไกต์, ชั้นนำอิเล็กตรอน, ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น

ภาควิชา เคมีเทคนิค	ลายมือชื่อนิสิต	argel Kar
สาขาวิชา เคมีวิศวกรรม	ลายมือชื่อนิสิต	จักรภัพร
	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก	

 Project Title
 Photophysical Study of Perovskite-Based Material for Photovoltaic

 Application
 Author

 Chakkapat Yaemthim
 Natprakhan Rotdonphai

Advisor Dr. Nuttapol Pootrakulchote

Department of Chemical Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Year 2019

ABSTRACT

Perovskite Solar Cells (PSCs) have witnessed to astounding improvement in power conversion efficiency (PCE) in the past decades. With this development PSCs are attracting research attention as the most promising candidate for the next generation of solar cells. However, the presence of a peculiar hysteresis behavior in the current density-voltage characteristic of these devices remains a key obstacle on the road to commercialization. The 3^+ cations are believed to reduce the hysteresis and thus improve the PCE of PSCs. In this study the effect of Boron-doping in the electron transport layer on the PCE of PSCs will be demonstrated. The Density Functional Theory (DFT) modelling method will be performed in this study, using Titanium dioxide as the electron transport layer in the methylammonium lead iodide perovskite solar cell. Based on the optimized energy densities obtained from DFT models the photovoltaic characteristics of the PSCs will be calculated. This study helps to understand the fundamental aspects of defect formation in TiO₂ and how to diminish it to improve the efficiency of solar cells.

Keywords: Perovskite solar cell, Electron transport layer, Density functional theory

Department of Chemical Technology

Major: Chemical Engineering

Student's signature	3172 605	
	2	
Student's signature	จักรภัพร	
Scadence S Signature		

Adviser's signature

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่องการศึกษากายภาพเชิงแสงของวัสดุฐานเพอรอฟสไกต์สำหรับโฟโตวอลเทอิกประยุกต์ สำเร็จด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก อ.ดร. ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัย ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อแนะนำ สถานที่และอุปกรณ์สำหรับการวิจัยครั้งนี้

และขอขอบคุณ อ.ดร. อรรณพ เอกธาราวงศ์ และดร. ธีรโชติ ภากรโชติ ที่ให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ และช่วยเหลือในการทำวิจัยนี้

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้างและผู้และผู้ที่สนใจ ศึกษาต่อไป

> คณะผู้วิจัย นายจักรภัทร แย้มทิม นายณัฐปคัลภ์ รอดดอนไพร

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ປ
กิตติกรรมประกาศ	ዋ
สารบัญ	१
สารบัญภาพ	ຊ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	2
1.4 ข้อจำกัดงานวิจัย	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	2
บทที่ 2 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น	3
2.2 โครงสร้างบกพร่องในไททาเนียมไดออกไซด์	8
2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน	
3.1 อุปกรณ์	
3.2 วิธีการดำเนินงาน	10
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง	
4.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์	14
4.1.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 0.00 eV	14
4.1.2 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 7.50 eV	15
4.2 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์	
4.2.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์ U = 0.00 eV	

4.3 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2	
4.3.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 U = 0.00 eV	19
4.3.2 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 U = 7.50 eV	20
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทดลอง	
5.2 ข้อเสนอแนะ	22

สารบัญภาพ

รูปที่	1	แผนภาพแสดงกระบวนการวิธีเซลฟ์คอนซิสแตนฟิลด์7
รูปที่	2	ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทส11
รูปที่	3	การกำหนดค่าการคำนวณของ Software11
รูปที่	4	ผลที่ได้จากการคำนวณโดย Software11
รูปที่	5	โครงสร้างไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทส (a) บริสุทธิ์ (b) โครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์
		(c) เจือด้วยโบรอน 8.3% (d) เจือด้วยโบรอน 4.2% (e) เจือด้วยโบรอน 2.1 %
รูปที่	6	แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 0.00 eV14
รูปที่	7	ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 0.00 eV 14
รูปที่	8	แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 7.50 eV
รูปที่	9	ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 7.50 eV 15
รูปที่	10	แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์
		U = 0.00 eV
รูปที่	11	ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะ
		ออกไซด์ U = 0.00 eV17
รูปที่	12	. แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 โดยอะตอม
		U = 0.00 eV
รูปที่	13	ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2
		โดยอะตอม U = 0.00 eV19
รูปที่	14	แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2
		โดยอะตอม U = 7.50 eV20
รูปที่	15	ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและมูลเหตุจูงใจในการเสนอโครงการ

ปัจจุบันโลกของเรารวมถึงประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องปริมาณทรัพยากรพลังงานจาก ฟอสซิล ได้แก่ถ่านหิน ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับความต้องการ ใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา[1] และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี นอกจากนั้นการใช้ พลังงาน ฟอสซิลยังก่อให้เกิดมลภาวะขึ้น ดังนั้นพลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจและศึกษา พัฒนาเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลที่เป็นแหล่งพลังงานหลักในปัจจุบันแหล่งพลังงานทางเลือกที่มี ศักยภาพในการพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนดังกล่าวคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) หรือเซลล์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic cell)[2] เซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งประเภทตามวัสดุที่ใช้ประกอบเซลล์หรือหลักการที่ ใช้สร้างกระแสไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ (Perovskite solar cell; PSC) ประกอบขึ้นจาก วัสดุเพอรอฟสไกต์ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในย่านความถี่ของแสงอาทิตย์ และมีแนวโน้มในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่าน มา[3] อย่างไรก็ตามการศึกษาผลขององค์ประกอบที่มีต่อระดับพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ PSC โดยวิธี แบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายนัก งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษากายภาพเชิงแสงของวัสดุฐานเพ อรอฟสไกต์โดยสร้างแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์สำหรับประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษากายภาพเชิงแสงของวัสดุฐานเพอรอฟสไกต์สำหรับโฟโตวอลเทอิกประยุกต์เพื่อปรับปรุง เสถียรภาพและศึกษากลไกการแยกประจุของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ (Perovskite solar cell)

3. ขอบเขตงานวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ในเรื่องระดับพลังงานสภาวะกับดัก (trap state) โดยมุ่งเน้นที่ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ทำหน้าที่เป็นชั้นนำอิเล็กตรอน (Electron transport layer; ETL) โดยแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ศึกษา

3.1.1 แถบพลังงาน (Band structure)

3.1.2 ความหนาแน่นของสถานะพลังงาน (Density of state)

4. ข้อจำกัดของงานวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาโดยแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์จึงส่งผลต่อสภาวะของแบบจำลองที่สร้างไม่ สามารถกำหนดขึ้นเองได้โดยสภาวะของจำลองคือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ (Absolute temperature; 0 K)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 5.1 ฝึกทักษะการทำงานวิจัยและแก้ปัญหา
- 5.2 เรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์เพื่อศึกษา
 - โครงสร้างพลังงานของวัสดุฐานเพอรอฟสไกต์
 - ระดับพลังงาน HOMO/LUMO

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

- 6.1 แผนการศึกษา
 - การเขียนโครงร่างงานวิจัย
 - ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 - ศึกษาการใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลอง
 - สร้างแบบจำลองที่สภาวะคงตัวของไททาเนียมไดออกไซด์
 - ■ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทส
 - ระดับพลังงาน HOMO/LUMO
 - ความหนาแน่นอิเล็กตรอนในสภาวะเร้า
 - ประกอบเซลล์ทดสอบ PSC และวัดระดับพลังงาน HOMO/LUMO เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จาก แบบจำลอง
 - สรุปผลการทดลองและเขียนปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น (Density functional theory, DFT)

ในทางกลศาสตร์ควอนตัม สมการชโรดิงเจอร์ ประสบความสำเร็จในการอธิบายอนุภาคเดี่ยวใน ศักย์ต่าง ๆ สำหรับอนุภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจะถูกอธิบายด้วยสมการชโรคิงจอร์ที่ขึ้นกับเวลา ซึ่งผล เฉลยมักจะถูกใช้ในการวิเคราะห์หาระดับพลังงานเละคุณสมบัติอื่น ๆ ของอิเล็กตรอนเดี่ยว อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่เหมาะสำหรับระบบที่ประกอบด้วยจำนวนอิเล็กตรอนมาก ๆ หรือที่เรียกว่า ระบบหลายอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัมสำหรับระบบนิวเคลียสและอิเล็กตรอนที่มีอันตรกิริยาต่อกัน สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ สมการชโรดิงเจอร์หลายอนุภาค

$$H\psi = E\psi$$
 2.1

โดย \hat{H} คือ แฮมิลโทเนียนของระบบสามารถเขียนในรูปของตัวดำเนินการ

$$\hat{H} = -\sum_{i} \frac{\hbar^{2}}{2m} \nabla_{i}^{2} - \sum_{i,I} \frac{Z_{I} e^{2}}{\left|\vec{r}_{i} - \vec{R}_{I}\right|} + \frac{1}{2} \sum_{i,J(j\neq i)} \frac{e^{2}}{\left|\vec{r}_{i} - \vec{r}_{j}\right|} - \sum_{I} \frac{\hbar^{2}}{2M} \nabla_{I}^{2} + \frac{1}{2} \sum_{I,J(J\neq I)} \frac{Z_{I} Z_{J} e^{2}}{\left|\vec{R}_{I} - \vec{R}_{J}\right|} \quad 2.2$$

เมื่อ M และ m คือมวลของนิวเคลียสและมวลของอิเล็กตรอนตามลำดับ R และ r "คือตำแหน่งของ นิวเคลียสและตำแหน่งของอิเล็กตรอนตามลำดับพจน์ทางขวามือในสมการ 2.2 ประกอบด้วยพลังงานจลน์ของ อิเล็กตรอนพลังงานศักย์ระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสพลังงานศักย์ระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอน พลังงานจลน์ของนิวเคลียสและพลังงานศักย์ระหว่างนิวเคลียสพลังงานศักย์ระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอน พลังงานจลน์ของนิวเคลียสและพลังงานศักย์ระหว่างนิวเคลียสกับนิวเคลียสตามลำดับ แต่การแก้ปัญหาของ สมการนี้เป็นไปได้ยากเนื่องจากถ้าระบบประกอบด้วยอนุภาค N ตัวจะทำให้ฟังก์ชันคลื่นมีระดับขั้นความเสรีถึง 3N จึงมีการเสนอแนวคิดว่านิวเคลียสเคลื่อนที่ช้ามากเมื่อเทียบกับอิเล็กตรอนดังนั้น" จึงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ ของอิเล็กตรอนเท่านั้นเรียกการประมาณนี้ว่าการประมาณของบอร์น-ออพเป็นไฮเมอร์ (Born-Oppenheimer approximation) จากการประมาณของบอร์น-ออพเป็นไฮเมอร์ฟังก์ชันคลื่นสามารถเขียนอยู่ในรูปของผลคูณ ระหว่างฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนกับฟังก์ชันคลื่นของนิวเคลียสทำให้พจน์ของพลังงานระหว่างนิวเคลียสกับ นิวเคลียสเป็นค่าคงที่และให้ความสำคัญในส่วนของอิเล็กตรอนดังนั้นแฮมิลโทเนียนของระบบอิเล็กตรอนที่ นิวเคลียสอยู่นิ่งสามารถเขียนได้เป็น

$$\hat{H} = -\sum_{i} \frac{\hbar^{2}}{2m} \nabla_{i}^{2} - \sum_{i,I} \frac{Z_{I} e^{2}}{|r_{i} - R_{I}|} + \frac{1}{2} \sum_{i,j(j \neq i)} \frac{e^{2}}{|r_{i} - r_{j}|}$$
2.3

ซึ่งแฮมิลโทเนียนนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตรงเนื่องจากความซับซ้อนของฟังก์ชันคลื่นในระบบ หลายอนุภาคการประมาณฟังก์ชันคลื่นของระบบหลายอนุภาคจึงเริ่มมีการคิดค้นโดยทฤษฎีของฮาร์ทรี (Hartree's theory) ซึ่งลดรูปฟังก์ชันคลื่นของระบบหลายอนุภาคที่ซับซ้อนให้กลายมาเป็นผลคูณของฟังก์ชัน คลื่นของอิเล็กตรอนเดี่ยว แต่ทฤษฎีฮาร์ทรีไม่สามารถอธิบายสมบัติปฏิสมมาตรของฟังก์ชันคลื่นของ อิเล็กตรอนได้ ต่อมาฮาร์ทรีและฟอกค์ได้เสนอฟังก์ชันคลื่นของระบบหลายอนุภาคให้อยู่ในรูปของ Slater determinant ของฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนเดี่ยวเพื่อแก้ปัญหาสมบติปฏิสมมาตรของอิเล็กตรอน สามารถ เขียนในรูปเมทริกซ์ได้เป็น

$$\psi(\vec{x}_{1},\vec{x}_{2},...,\vec{x}_{N}) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_{1}(\vec{x}_{1}) & \psi_{2}(\vec{x}_{1}) & \cdots & \psi_{N}(\vec{x}_{1}) \\ \psi_{1}(\vec{x}_{2}) & \psi_{2}(\vec{x}_{2}) & \cdots & \psi_{N}(\vec{x}_{2}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{1}(\vec{x}_{N}) & \psi_{2}(\vec{x}_{N}) & \cdots & \psi_{N}(\vec{x}_{N}) \end{vmatrix}$$
2.4

ซึ่งทฤษฎีของฮาร์ทรีฟอกค์สามารถอธิบายระบบเล็ก ๆ ที่มีสมบัติปฏิสมมาตรของฟังก์ชันคลื่นและ อันตรกิริยาแลกเปลี่ยน แต่ยังไม่รวมผลของสหสัมพันธ์ระเบียบวิธีของฮาร์ทรีฟอกค์จึงไม่เหมาะที่จะใช้ แก้ปัญหาระบบที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมาก ๆ เนื่องจากใช้ทรัพยากรในการคำนวณมากดังนั้นทฤษฎีฟังก์ชันนัล ความหนาแน่น (Density Functional Theory) จึงมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะใช้แก้ปัญหาระบบหลาย อนุภาคในของแข็งเนื่องจากทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นประกอบด้วยพลังงานแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ที่มี ความใกล้เคียงกับระบบจริง

ฟังก์ชันนัลความหนาแน่นเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา ระบบหลายอนุภาคซึ่งทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นเป็นระเบียบวิธีที่ใช้กฎพื้นฐานทางฟิสิกส์ แต่มีการ ประมาณค่าในส่วนของพลังงานแลกเปลี่ยนสหสัมพันธ์โดยฟังก์ชันนัลความหนาแน่นเริ่มจากทฤษฎีบทโฮเฮ นเบิร์ก-โอห์น

ทฤษฎีบทโฮเฮนเบิร์ก-โคห์น (Hohenberg-Kohn Theorem)

ทฤษฎีบทโฮเฮนเบิร์ก-โคห์นสำหรับระบบที่มีสถานะพื้น มีทั้งหมด 2 ข้อ คือ

 สำหรับระบบที่มีอนุภาคที่มีแรงกระทำต่อกันอยู่ภายใต้ศักย์ภายนอก V_{ext}(r) พลังงานของระบบที่ สถานะพื้นจะเป็นฟังก์ชันนัลแบบหนึ่งต่อหนึ่งของความหนาแน่นอิเล็กตรอน n₀(r)

$$E = E[n(r)]$$
 2.5

2. ค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่แท้จริงของระบบเกิดจากค่าพลังงานที่ต่ำสุดของระบบ

$$\mathsf{E}_0 = \mathsf{E}[\mathsf{n}_0(\overline{\mathsf{r}})] \le \mathsf{E}[\mathsf{n}(\overline{\mathsf{r}})]$$

ทำให้สามารถใช้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนแทนฟังก์ชันคลื่นในการแก้ปัญหาสมการชโรดิงเจอร์ได้

สมการโคห์น-ชาม (Kohn-Sham equaton)

จากทฤษฎีบทโฮเฮนเบิร์ก-โคห์น โคห์น-ชามเขียนพลังงานรวมของระบบในรูปฟังก์ชันนัลได้

$$E[n] = T_s[n] + U[n] + E_{xc}[n]$$
 2.7

โดย T_s คือพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน

U คือพลังงานศักย์ที่ประกอบด้วยอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนหรือพลังงาน ฮาร์ทรีและพลังงานศักย์ภายนอกที่มาจากศักย์คูลอมบ์ของนิวเคลียส

E_{xc} คือพลังงานแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ที่เกิดจากอันตรกิริยาของอิเล็กตรอน

สำหรับพจน์พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของอิเล็กตรอนเป็นพจน์ที่สามารถเขียนได้ในรูปแบบเชิง วิเคราะห์ส่วนผลทุกอย่างที่นอกเหนือจากนั้นจะรวมอยู่ในพจน์พลังงานแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถหา ค่าแม่นตรงได้จึงมีการเสนอการประมาณค่าพลังงานแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวในภายหลัง หลังจากนั้นโคห์นและชามได้หาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนัลของสมการที่ 2.7 จะได้สมการที่มีลักษณะคล้ายกับชโร-ดิงเจอร์เรียกสมการโคห์น-ชามเขียนได้ดังนี้

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{eff}\left(\vec{r}\right)\right]\varphi_i\left(\vec{r}\right) = \varepsilon_i\varphi_i\left(\vec{r}\right)$$
2.8

ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระบบอิเล็กตรอนเดี่ยวที่อยู่ภายใต้ศักย์ยังผล (Effective potential) V_{eff}(r) เท่านั้นโดยพจน์ศักย์ยังผลเขียนอยู่ในรูป

$$V_{\text{eff}}(\vec{r}) = V_{\text{ext}}(\vec{r}) + V_{\text{H}}(\vec{r}) + V_{\text{xc}}(\vec{r})$$
2.9

โดย V_{ext}(r) คือศักย์ภายนอกที่มาจากศักย์คูลอมบ์ของนิวเคลียส

V_H(r) คือศักย์ที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนหรือศักย์ฮาร์ทรี V_{xc}(r) คือศักย์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน-สหสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาสมการโคห์น-ชามจะพบว่าศักย์ยังผลขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอิเล็กตรอนซึ่งความ หนาแน่นของอิเล็กตรอนทราบได้จากฟังก์ชันคลื่น และฟังก์ชันคลื่นคำนวณจากสมการโคห์น-ชามที่ต้องทราบ ค่าศักย์ยังผลก่อน ดังนั้นจึงใช้วิธีการเซลฟ์คอนซิสแตนฟิลด์ (self-consistent field) ในการแก้ปัญหาสมการ โคห์น-ชาม สำหรับระบบของแข็งที่มีลักษณะเป็นคาบ จะใช้ทฤษฎีบทของบลอค (Bloch's theorem) มา พิจารณาซึ่งฟังก์ชันของคลื่นของอิเล็กตรอนจะอยู่ในรูปของผลคูณของคลื่นระนาบ ดังสมการ

$$\varphi_{\bar{k}}\left(\vec{r}\right) = u_{\bar{k}}\left(\vec{r}\right)e^{i\bar{k}\cdot\bar{r}}$$
2.10

โดย k คือ เวกเตอร์คลื่น (wave vector) ซึ่งภายใต้เงื่อนไขของทฤษฎีบทของบลอค ค่าเจาะจงและ ฟังก์ชันคลื่น ต้องเป็นไปตามสมการ

$$E\left(\vec{k}\right) = E\left(\vec{k} + \vec{G}\right) \tag{2.11}$$

โดย G คือ เวกเตอร์ของโครงผลึกส่วนกลับ (Reciprocal lattice vector) และค่า G ที่มากที่สุด เกี่ยวข้องกับพลังงานคัทออฟฟ์ (cutoff energy)

$$E_{cut} = \frac{\hbar^2 \overline{G}_{\max}^2}{2m}$$
 2.12

และฟังก์ชันคลื่นที่มีลักษณะเป็นคาบถูกให้นิยามเป็นผลรวมของเซตฐานคลื่นระนาบ จึงเขียนฟังก์ชัน คลื่นได้ในลักษณะ

$$\varphi_{\bar{k}}\left(\vec{r}\right) = \sum_{j} c_{j}\left(\vec{k}\right) e^{i\left(\vec{k}+\vec{G}\right)\cdot\vec{r}}$$
2.13

โดย c_j(k) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของฐานนั้น ๆ ซึ่งค่าเริ่มต้นของค่า c_j(k) จะสุ่มตัวเลขเพื่อนำมาคำนวณหา ค่าความหนาแน่นอิเล็กตรอนจากสมการ

$$n\left(\vec{r}\right) = \sum_{i} \left|\varphi_{i}\left(\vec{r}\right)\right|^{2}$$
2.14

เพื่อนำไปสร้างศักย์ยังผลในสมการ 2.9 จากนั้นจึงแก้ปัญหาสมการโคห์น-ชามในสมการ 2.8 โดยใช้ เมทริกซ์ซึ่งจะได้ค่าเจาะจงออกมาและเซตคำตอบของ {c} ใหม่จึงนำไปคำนวณหาค่าความหนาแน่นของ อิเล็กตรอนใหม่ในสมการ 2.14 แล้วเปรียบเทียบความหนาแน่นของอิเล็กตรอนใหม่กับความหนาแน่นของ อิเล็กตรอนเก่าเมื่อความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมีค่าไม่ต่างจากเดิมจะหยุดกระบวนการและความหนาแน่น ของอิเล็กตรอนนั้นจะเป็นค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นหลังจากนั้นจะใช้ความหนาแน่นของ อิเล็กตรอนนี้ไปคำนวณหาพลังงานรวมของระบบที่สถานะพื้นในสมการ 2.7 แต่ถ้าเปรียบเทียบความหนาแน่น ของอิเล็กตรอนแล้วพบว่าค่าทั้งสองต่างกันจะนำค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนไปสร้างศักย์ยังผลและเข้าสู่ กระบวนการทำซ้ำต่อไปจนกว่าค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมีค่าไม่ต่างจากค่าความหนาแน่นของ อิเล็กตรอนในรอบก่อนสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังรูปที่ 1[4]



รูปที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการวิธีเซลฟ์คอนซิสแตนฟิลด์

2.2 โครงสร้างบกพร่องในไททาเนียมไดออกไซด์

ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม ได้ดูกนำมาใช้กัน อย่างแพร่หลายเช่น ในครีมกันแดด, สีทา, ขี้ผึ้ง, ยาสีฟันและตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุกึ่งตัวนำ ชนิดอื่น ๆ ไททาเนียมไดออกไซด์มีข้อดีหลายประการสำหรับปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาเซิงแสงและยังมีความเป็น พิษต่ำ มีความเสถียรภาพทางด้านเคมีและความร้อน แต่อย่างไรก็ตามไททาเนียมไดออกไซด์ สามารถพบความ บกพร่องในผลึกได้ ซึ่งจะทำให้สมรรถนะการเร่งปฏิกิริยาเซิงแสงของไททาเนียมไดออกไซด์ สามารถพบความ บกพร่องในผลึกได้ ซึ่งจะทำให้สมรรถนะการเร่งปฏิกิริยาเซิงแสงของไททาเนียมไดออกไซด์ สามารถพบความ บกพร่องออกซิเจน (Oxygen vacancy) ในโลหะออกไซด์เป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดความบกพร่องของผลึก การหายไปของออกซิเจนสามารถทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับที่มีความสำคัญและเป็นตำแหน่งกัมมันต์ (active site) สำหรับการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ (Heterogenous catalysis) ที่แตกต่างกันซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริยา ของออกไซด์โลหะ ในอีกทางการเกิดขึ้นของตำแหน่งออกซิเจนที่ ว่างบนไททาเนียมไดออกไซด์ นำไปสู่การ สร้างอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวหรือเกิด Ti³⁺ ที่ศูนย์กลาง ซึ่งสามารถสร้างขั้นให้อิเล็กตรอนในโครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ของไททาเนียมไตออกไซด์ นอกจากนี้ตำแหน่งที่ว่างของออกซิเจนจะส่งผลกระทบต่อ กระบวนการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนหลุม (eletron-hole pairs) ในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ขึ้นอยู่กับการถ่ายโอนประจุจากอิเล็กตรอนหรือหลุม ผลทางทฤษฎี และการทดลองแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนส่วนเกินที่อยู่ในสถานะที่ว่างออกซิเจนมีผลต่อการดูดซับบนพื้นผิว และการเกิดปฏิกิริยาของตัวดูงซ์ที่สำคัญ เช่น ออกซิเจนหรือน้ำบนไททาเนียมไดออกไซด์[5]

2.3 เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Lei Li และคณะ[6] ได้ศึกษาผลกระทบของการเจือโบรอน (B-doping) ฟอสฟอรัส (P-doping) และ โบรอนผสมฟอสฟอรัส (B/P-codoping) ที่มีต่อโครงสร้างแถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ที่มี รูปผลึกแบบอนาเทส (anatase) โดยใช้หลักการคำนวณตามทฤษฎีความหนาแน่น (Density functional theory; DFT) ผลการศึกษาพบว่า (ก) การเจืออะตอมโบรอนหรือฟอสฟอรัสเข้าไปในผลึกของ TiO₂ ทำให้ โครงสร้างผลึกบริเวณโดยรอบอะตอมโบรอนหรือฟอสฟอรัสเก้อภาวะโคออร์ดิเนชันไม่ครบ (undercoordination effect) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของโครงสร้างบริเวณการเจืออ่อนลง (local bond relaxation) และอิเล็กตรอนถูกตรึงให้อยู่ใกล้กับอะตอมมากขึ้น (core electron entrapment) (ข) ความ หนาแน่นของอิเล็กตรอนบริเวณใกล้กับอะตอมที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดเป็นชั้นพลังงานแทรกในช่องว่างระหว่าง แถบพลังงาน (band gap) ส่งผลให้ผลึก TiO₂ สามารถดูดกลืนแสงในย่านที่มองเห็นได้ (visible light) และลด อัตราการตกกลับของอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสง (ค) นอกจากนั้น ความหนาแน่นอิเล็กตรอน บริเวณใกล้กับอะตอมที่เพิ่มขึ้น ยังเหนี่ยวนำให้อิเล็กตรอนอิสระ (nonbonding electrons) ในแถบนำไฟฟ้า และแถบวาเลนซ์ของ TiO₂ เกิดสภาพมีขั้ว (polarized) ขึ้น ทำให้ขอบล่างของแถบนำไฟฟ้าเข้าใกล์ขอบบน ของแถบวาเลนซ์มากขึ้น ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างแถบพลังงานแคบลง และระดับพลังงานฟังก์ชันงาน (working function) ของ TiO₂ ลดลง (ง) ระดับพลังงานฟังก์ชันงานที่ลดลงส่งผลให้อิเล็กตรอนในวงนอกสุด ของอะตอมไวปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น (reactive) ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการออกแบบและ สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูงต่อไป

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน

อุปกรณ์

- Software : biovia materials studio castep

วิธีการดำเนินงาน

- 1. สร้างโครงสร้าง ไททาเนียมไดออกไซด์
 - 1.1 กำหนดค่า Lattice parameter ในการสร้างแบบจำลองโครงสร้างไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทส
 - 1.2 Add atom ในโครงสร้าง Crystal ที่ทำการสร้างไว้
- 2. กำหนด Set up การคำนวณของ Software ดังต่อไปนี้
 - 2.1 Task : Geometry Optimization
 - 2.2 Quality : Ultra-fine
 - 2.3 Functional : GGA PBE
 - 2.4 Spin polarized
 - 2.5 Use LDA+U
- 3. กำหนด Properties การคำนวณของ Software ดังต่อไปนี้
 - 3.1 Band structure
 - 3.2 Density of states
- เริ่มทำการคำนวณโครงสร้าง,Band structure และ density of states ของโครงสร้างไททาเนียมได ออกไซด์อนาเทส
- 5. ทำการวิเคราะห์ผลการคำนวณของ Software ดังต่อไปนี้
 - 6.1 โครงสร้างของ ไททาเนียมไดออกไซด์
 - 6.2 โครงสร้าง Band structure ของ ไททาเนียมไดออกไซด์
 - 6.3 โครงสร้าง Density of states ของ ไททาเนียมไดออกไซด์

Rebuild Crystal	Add Atoms
Space Group Lattice Parameters Options Lattice type: 3D Triclinic Lengths (A)	Atoms Options Bernent: B Name: B Oxidation 0 Oxidation: 0 Occupancy: 1.0 Cocupancy: 1.0 Cocupancy: 1.0 Cocupancy: C Anisotropic Anisotropic
Rebuild Apply Cancel Help	AddHelp

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสร้างโครงสร้าง ไททาเนียมไดออกไซด์ Anatase phase

Core level spectroscopy
Density of states
Electron localization function
Electronic excitations
Band structure
Energy range: 10.0 eV
k-point set:
Separation: 0.015 1/A More

ร**ูปที่ 3** การกำหนดค่าการคำนวณของ Software



รูปที่ 4 ผลที่ได้จากการคำนวณโดย Software

งานวิจัยนี้ศึกษาโดยการสร้างแบบจำลองด้วย Spin-polarized DFT model ของ CASTEP package ซึ่ง Electron – ionic core interaction ถูกอธิบายด้วย Generalized gradient approximation (GGA) โดย PBE functional โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดของไททาเนียมไดออกไซด์ถูกคำนวณโดย Plane-wave basis และ cutoff energy คือ 380 eV

หลังจากโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดของไททาเนียมไดออกไซด์ถูกคำนวณแล้วโครงสร้างนั้นจะถูกนำไป คำนวณหา Electronic structure ดังต่อไปนี้

- 1. Band structure
- 2. Density of states
- โดยโครงสร้างที่ทำการศึกษาในการวิจัยนี้ได้แก่
- 1. ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสแบบบริสุทธิ์
- 2. ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์
- 3. ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 8.3 โดยอะตอม
- 4. ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 โดยอะตอม
- 5. ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 2.1 โดยอะตอม

แต่อย่างไรก็ตามค่า Band gap ของสารกึ่งตัวนำที่ได้จากการคำนวณโดย DFT มีค่าที่ไม่สอดคล้องกับค่า ความเป็นจริง ดังนั้นการ on-site correction ด้วยวิธีการ GGA+U จึงถูกนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อให้ได้ค่า Band gap ที่สอดคล้องกับค่าที่ได้จากการทดลอง [7-8] ซึ่งเห็นได้จากเมื่อค่า U = 7.50 eV ถูกนำไปใช้กับ อิเล็กตรอนในชั้น 3d ของอะตอมไททาเนียม ค่า Band gap ของไททาเนียมไดออกไซด์ที่คำนวณได้จึงมีค่า 3.154 eV ใกล้เคียงกับค่า Band gap ของไททาเนียมไดออกไซด์ในความเป็นจริง (3.2 eV)



ร**ูปที่ 5** โครงสร้างไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทส (a) บริสุทธิ์ (b) โครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์ (Oxygen vacancies) (c) เจือด้วยโบรอน 8.3% โดยอะตอม (d) เจือด้วยโบรอน 4.2% โดยอะตอม (e) เจือ ด้วยโบรอน 2.1% โดยอะตอม



4.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์

4.1.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 0.00 eV







รูปที่ 7 ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 0.00 eV



4.1.2 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 7.50 eV

รูปที่ 8 แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 7.50 eV



รูปที่ 9 ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ U = 7.50 eV

ผลของการปรับปรุงแบบจำลอง plan-wave DFT มาตรฐาน ด้วยวิธี Hubbard correction

โครงสร้างแถบพลังงาน (band structure) ของ ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ ปรียบเทียบ ระหว่างแบบจำลอง plan-wave DFT มาตรฐาน (GGA) และแบบจำลองมาตราฐานที่ผ่านการ on-site correction ด้วยการเติมค่า U=7.50 eV (GGA+U7.50) ให้กับอิเล็กตรอนใน Ti 3d ออร์บิทัล พบว่า ช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (band gap) ของ ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ มีค่าเป็น 2.227 และ 3.154 eV ตามลำดับ โดยกรณี GGA+U7.50 ให้ค่า band gap ใกล้เคียงกับผลการทดลองจริงมาก ที่สุด (Eg = 3.2 eV)

กราฟแสดงความหนาแน่นสภาวะเสมือน (PDOS) ของแต่ละอะตอมในโครงสร้างของไททาเนียมได ออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ กรณี GGA+U7.50 แสดงให้เห็นว่าระดับพลังงานในแถบนำไฟฟ้า (conduction band) ส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณ Ti 3d ออร์บิทัล ขณะที่ระดับพลังงานในแถบวาเลนซ์ (valence band) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย O 2p ออร์บิทัล โดยมี Ti 3d ออร์บิทัลเป็นส่วนประกอบร่วมด้วยในบริเวณ ช่วงพลังงานต่ำของแถบวาเลนซ์



4.2 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์ (Oxygen vacancies) 4.2.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์ U = 0.00 eV

รูปที่ 10 แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสโครงสร้างบกพร่องในโลหะออกไซด์ U = 0.00 eV



รูปที่ 11 ความหนาแน่นของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสสถานะพลังงานของโครงสร้างบกพร่องในโลหะ ออกไซด์ U = 0.00 eV ผลของ Oxygen vacancies ในโครงสร้างผลึกไททาเนียมไดออกไซด์

โครงสร้างแถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสบริสุทธิ์ที่มี Oxygen vacancies (nonstoichiometric TiO₂) ที่เกิดจากการดึงอะตอมออกซิเจนออกจากโครงสร้างผลึก พบว่าระดับพลังงานสูงสุด ของแถบวาเลนซ์ (VBM) และระดับพลังงานต่ำสุดของแถบนำไฟฟ้า (CBM) ลดต่ำลงเมื่อเทียบกับ VBM และ CBM ของ stoichiometric TiO₂ อีกทั้งช่องว่างระหว่างแถบพลังงานแคบลงด้วย ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนอะตอม ออกซิเจนในโครงสร้างผลึกไม่ครบตามอัตราส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ ทำให้อิเล็กตรอนของ O 2p ออร์บิทัลใน VB หายไป และอิเล็กตรอนที่สร้างพันธะร่วมกับออกซิเจนบางส่วนกลับคืนสู่ Ti 3d ออร์บิทัลใน CB [<u>10</u>]

โครงสร้างผลึกไททาเนียมไดออกไซด์ ในภาวะ non-stoichiometric ไม่เสถียรเนื่องจาก Ti(IV) ใน โครงสร้างผลึกถูกรีดิวซ์โดยอิเล็กตรอนที่กลับคืนสู่ Ti 3d ออร์บิทัล เกิดเป็น Ti(III) มีสมบัติว่องไวต่อการ เกิดปฏิกิริยา

4.3 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2



4.3.1 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 U = 0.00 eV

รูปที่ 12 แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 โดยอะตอม U = 0.00 eV



รูปที่ 13 ความหนาแน่นของสถานะพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 โดยอะตอม U = 0.00 eV



4.3.2 ไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 U = 7.50 eV

รูปที่ 14 แถบพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์อนาเทสเจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 โดยอะตอม U = 7.50 eV





ผลของการเจือโบรอนร้อยละ 4.2 โดยน้ำหนักเข้าไปในโครงสร้างผลึกไททาเนียมไดออกไซด์

โครงสร้างแถบพลังงานของ ไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 โดยอะตอม (GGA+U7.50) เปรียบเทียบกับไททาเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์ (GGA+U7.50) พบว่าช่องว่างระหว่าง แถบพลังงานของ ไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยโบรอน ลดลงจาก 3.154 eV (กรณีไททาเนียมไดออกไซด์ บริสุทธิ์) เหลือ 2.54 eV (รูปที่ 14) และพบว่าการเจือโบรอนทำให้เกิดระดับพลังงานขึ้นในช่องว่างระหว่าง แถบพลังงาน เรียกว่าระดับพลังงานสภาวะกับดัก (trap state) เนื่องจากระดับพลังงานเหล่านี้กักเก็บ อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้น (excitation) จากแถบวาเลนซ์ ขณะเดียวกันยังสามารถรองรับอิเล็กตรอนที่ตกกลับ (recombination) จากแถบนำไฟฟ้า มีผลทำให้สมบัติเชิงแสงและเคมีไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป[7]

นอกจากนั้น การเจืออะตอมของโบรอนในโครงสร้างผลึกของ ไททาเนียมไดออกไซด์ มีผลทำให้ระดับ พลังงาน VBM และ CBM ลดต่ำลงอย่างมาก ทำให้ขีดความสามารถการรีดิวซ์และออกซิไดซ์ (reducing/oxidizing ability) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยโบรอน เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงกว่า และเป็นตัวรีดิวซ์ที่อ่อนกว่าไททาเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาพบว่าเมื่อไททาเนียมไดออกไซด์เกิดภาวะพร่องออกซิเจน(Oxygen vacancies) พบว่า ระดับพลังงานสูงสุดของแถบวาเลนซ์ (VBM) และระดับพลังงานต่ำสุดของแถบนำไฟฟ้า (CBM) ลดต่ำลง และ เมื่อ เจือไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยโบรอนร้อยละ 4.2 โดยอะตอม พบว่าพบว่าช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน ของ ไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยโบรอน ลดลงจาก 3.154 eV เหลือ 2.54 eV พร้อมทั้งส่งผลทำให้เกิดระดับ พลังงานขึ้นในช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน เรียกว่าระดับพลังงานสภาวะกับดัก (trap state)ผลทำให้สมบัติ เชิงแสงและเคมีไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปและทำให้ระดับพลังงาน VBM และ CBM ลดต่ำลงอย่างมาก โดยไททา เนียมไดออกไซด์เจือด้วยโบรอนเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงกว่า และเป็นตัวรีดิวซ์ที่อ่อนกว่าไททาเนียมไดออกไซด์ บริสุทธิ์

5.2 ข้อเสนอแนะ

ควรมีผลการทดลองจริงเพื่อมายืนยันความถูกต้องจากผลการจำลองด้วยทฤษฎีฟังก์ชันนัลความ หนาแน่น (Density functional theory, DFT)

รายการอ้างอิง

- Traivivatana S., Wangjiraniran W., Junlakarn S., Wansophark N., (2017). Thailand Energy Outlook for the Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB). *Energy Procedia* 138, 399– 404.
- [2] Traivivatana S., Wangjiraniran W., (2019). Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB): One Step towards sustainable Energy Sector. *Energy Proceedia* 157, 492-497.
- [3] Odabaşı Ç., Yıldırım R., (2017). Performance analysis of perovskite solar cells in 2013–
 2018 using machine-learning tools. *Nano Energy 56*, 770-791.
- [4] ธิติ บวรรัตนารักษ์. (2014). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพื้นฐานโดย เทคนิค สภาวะรุนแรง : รายงานฉบับสมบูรณ์. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- [5] Pan, X., Yang, M. Q., Fu, X., Zhang, N., & Xu, Y. J. (2013). Defective TiO 2 with oxygen vacancies: synthesis, properties and photocatalytic applications. Nanoscale, 5(9), 3601-3614.
- [6] Li, L., Meng, F., Hu, X., Qiao, L., Sun, C. Q., Tian, H., & Zheng, W. (2016). TiO2 band restructuring by B and P dopants. *PloS one*, 11(4).
- [7] Allen JP, Watson GW. Occupation matrix control of d- and f-electron localisations using DFT + U. *Phys Chem Chem Phys.* 2014; 16:21016. doi: 10.1039/c4cp01083c PMID: 24832683.
- [8] Finazzi E, Di Valentin C, Pacchioni G, Selloni A. Excess electron states in reduced bulk anatase TiO2: comparison of standard GGA, GGA+U, and hybrid DFT calculations. J Chem Phys. 2008; 129 (15):154113. doi: 10.1063/1.2996362 PMID: 19045182.
- [9] Pathak, S. K., Abate, A., Ruckdeschel, P., Roose, B., Gödel, K. C., Vaynzof, Y., Sepe, A. (2014). Performance and stability enhancement of dye-sensitized and perovskite solar cells by Al doping of TiO2. *Advanced Functional Materials*, 24(38), 6046-6055.
- [10]Zhu HX, Zhou PX, Li X, Liu JM. Electronic structures and optical properties of rutile
 TiO₂ with different point defects from DFT+U calculations. *Phys Lett A.* 2014;
 378(36):2719–24.
- [11]Nie, X., Zhuo, S., Maeng, G., & Sohlberg, K. (2009). Doping of TiO2 polymorphs for altered optical and photocatalytic properties. *International Journal of Photoenergy, 2009*.